

一般整流ダイオード Rectifier Diode

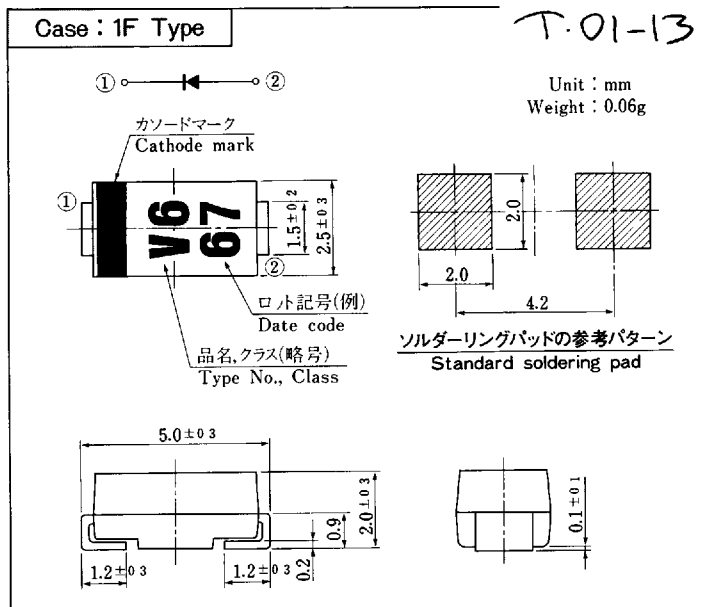
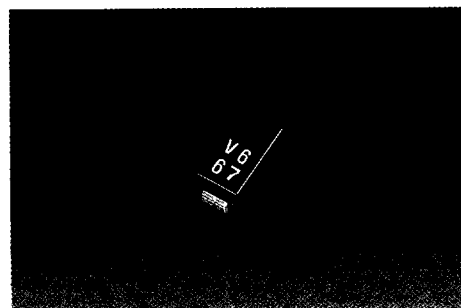
単体型 Single Diode

SHINDENGEN ELECTRIC MFG 54E D ■ 8219387 0000685 953 ■ SHEJ

D1F□

600V 1A

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

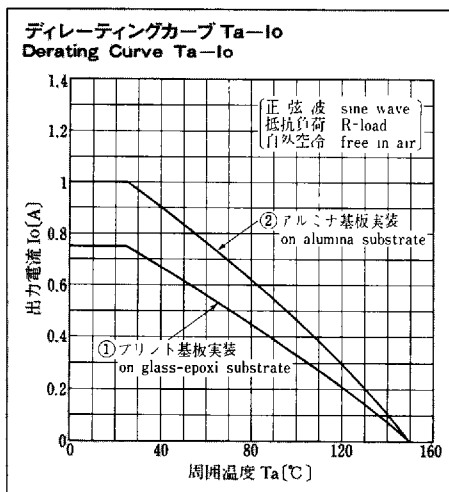
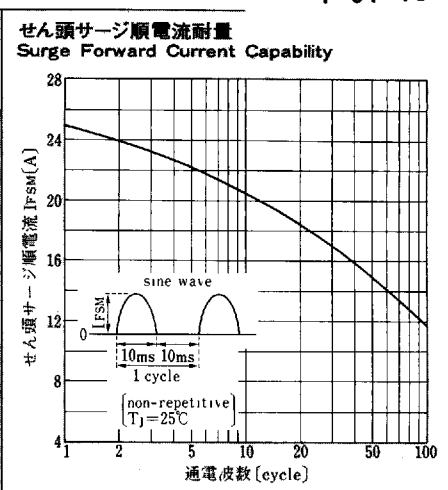
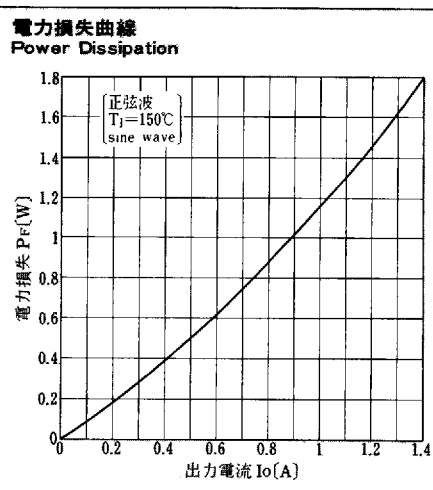
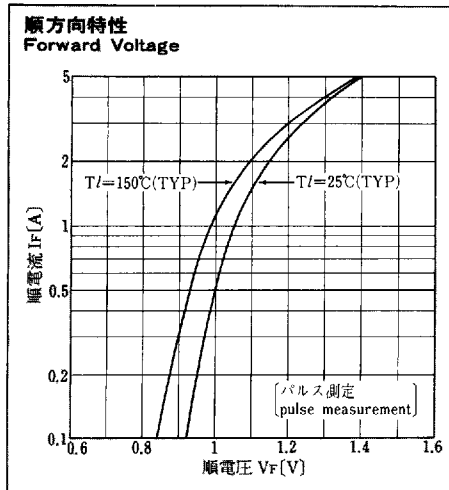
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1F10	D1F20	D1F40	D1F60	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150				℃
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj			150				℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			100	200	400	600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Ta=25℃ 50Hz sine wave, R-load, Ta=25℃	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1				A
			プリント基板実装 On glass-epoxi substrate	0.75				
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃		25				A

電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (Tl=25℃)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=1A, パルス測定 IF=1A, Pulse measurement		MAX	1.1	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, パルス測定 VR=VRM, Pulse measurement		MAX	10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θjl	接合部・リード間 Junction to lead		MAX	23	℃/W
	θja	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	MAX	108	
			プリント基板実装 On glass-epoxi substrate	MAX	157	

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

T-01-13



	①	②
フリントラント soldering land	2 mm \square	2 mm \square
導体箔 conductor layer	35 μm	20 μm
基板の厚さ substrate thickness	---	0.64mm